Električni transport u sustavima s jakim elektronskim korelacijama

Marko Kuveždić

Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb, Hrvatska

Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Basletić

Organski vodiči

• Vodljivi polimeri



- Organske soli •
 - Molekularni kristali
 - Kompleksi s prijenosom naboja



TTF

TSF



TMTTF







M(dmit)₂











DCNQ



DMET

BEDO-TTF

BEDT-TTF or ET





Perylene



Ni(tmdt)₂

Buckminsterfullerene or C60

Organske soli

- Pozadina:
 - W. A. Little, Phy. Rev. 134 (1964)
 - Supravodljivost u organskim materijalima iznad sobne temperature
 - Prva vodljiva organska sol s metalnom prirodom (1973)
 - (TTF)(TCNQ)
 - Donorska molekula: TTF (*tetrathiafulvalene*)
 - Akceptorska molekula: TCNQ (*tetracyanoquinodimethane*)
 - Prva organska sol sa supravodljivm prijelazom (1979)
 - $(TMTSF)_2PF_6$
 - Donorska molekula: TMTSF (*tetramethyltetraselenafulvalene*)
 - Akceptorska molekula: PF₆
 - T_C = 0.9K pri tlaku od 1.2GPa

Organske soli

- Trenutno stanje:
 - Nije otkriven supravodljivi prijelaz blizu sobne temperature
 - Najviši otkriveni prijelaz pri atmosferskom tlaku: κ-(BEDT-TTF)₂Cu[N(CN₂)]Br
 - Donorska molekula: BEDT-TTF (bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)
 - Akceptorska molekula: Cu[N(CN₂)]Br
 - T_C=11.6K
 - Otkriven veliki broj građevnih jedinica
 - Pokazali su niz zanimljivih pojava: val gustoće naboja (CDW) i spina (SDW), uređenje naboja (CO), antiferomagnetska i spin-Pierls stanja, metalno-izolatorske i supravodljivoizolatorske prijelaze, nekonvencionalnu supravodljivost.

Organske soli



BEDT-TTF

• Skupina: BEDT-TTF (*bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene*)





- Slojevita građa:
 - Vodljivi sloj BEDT-TTF molekula (donori)
 - Izolirajući sloj aniona (akceptori)
 - Kvazi-2D vodljivost



BEDT-TTF

• Unutar ravnine BEDT-TTF molekule se orijentiraju na više načina



• Najviše otkrivenih supravodljivih spojeva

- I₃ akceptroski anion
- α kristalna faza
- Po dvije BEDT-TTF molekule predaju jedan elektron I₃ anionu
- U prosjeku BEDT-TTF^{0.5+}
- $\sigma_a > \sigma_b \gg \sigma_c$



- Triklinska kristalna rešetka
 - 4 BEDT-TTF molekule: A, A', B i C
 - Dva stupca molekula:
 - Stupac I od A i A' molekula
 - Stupac II od B i C molekula



- Na soboj temperaturi:
 - Ponaša se kao polumetal
 - A i A' molekule su kristalografski indentične
- Na temperaturi T_{MI}=136K posjeduje metalno-izolatorski prijelaz
 - Vodljivost pada za nekoliko redova veličine
 - Dolazi do uređenja naboja
- Ispod prijelaza:
 - Promjena dihedralnih kutova ⇒ Lom simetrije između A i A' molekula
 - Deformacija strukture BEDT-TTF molekula ⇒ disproporcija naboja među molekulama

- Naboj molekula ispod T_{MI}: 0.82(9)e za A, 0.29(9)e za A', 0.73(9)e za B te 0.26(9)e za C
- Dolazi do pojave nabojem bogatih pruga građenih od A i B molekula te nabojem siromašnih pruga od A' i C molekula.



 Uz (A, B) postoji i (A', B) bogato uređenje ⇒ feroelektrična priroda uređenja naboja

- Nova istraživanja pomoću dielektrične spektroskopije ukazuju da je uređenje naboja u α-(BEDT-TTF)₂I₃ bolje opisano kooperativnim valom gustoće veza i naboja, nego standardnim viđenjem potpuno lokaliziranog Wignerovog kristala
- 2k_f modulacija integrala preklopa u pi i p2 smjerovima
 > dugovalna pobuđenja s anizotropnom fazonski sličnom disperzijom Stack I II II II II



- Domenski zidovi između (A, B) bogatih područja i (A', B) bogatih područja => Temperaturno neovisna kratkovalna pobuđenja naboja u obliku parova domenskih zidova
- Dodatno podupire feroelektričnu prirodu uređenja naboja ispod T_{MI}





- Dva relaksacijska moda
- Mali mod je temperaturno neovisan i vidljiv tek ispod
 ≈75K, iznad te temperature je u potpunosti prekriven
 velikim relaksacijskim modom



Paraelektrično-feroelektrični fazni prijelaz

• Landauova teorija faznih prijelaza drugog reda

$$F = f_0 + \frac{1}{2}f_2P^2 + \frac{1}{4}f_4P^4 + \dots - EP$$

Uvjeti ravnoteže Spontana p





Paraelektrično-feroelektrični fazni prijelaz

• Električna susceptibilnost χ:

$$\frac{1}{\chi} = \frac{\partial E}{\partial P} = \frac{\partial^2 F}{\partial P^2} \Big|_{P=P_0} = a(T - T_0) + 3bP_0^2$$

• Uvršatavnjem spontane polarizacije:

$$\chi = \frac{1}{a}(T - T_0)^{-1}$$
, za $T > T_0$,

$$\chi = \frac{1}{2a} (T_0 - T)^{-1}$$
, $\operatorname{za} T < T_0$

 Predviđa da je nagib χ-1 ispod prijelaza duplo veći od nagiba iznad prijelaza



Paraelektrično-feroelektrični fazni prijelaz

• Ovakav prijelaz već je zabilježen kod drugih organskih soli (P. Monceau et al. Phy. Rev. Lett. 86 (2001))



Mjerenja

- Ovisnost dielektrične funkcije o temperaturi za odabrane frekvencije, kako bi:
 - Potvrdili relakscijsko ponašanje oko 75K
 - Zabilježili paraelektrično-feroelektrični fazni prijelaz na T_{MI}
- Ovisnost otpornosti o temperaturi, kako bi :
 - Usporedili uzorak sa poznatim svojstvima α -(BEDT-TTF) $_2I_3$ spoja
 - Usporedili rezultate sa mjerenjima dielektrične funkcije

- Uzorak:
 - α -(BEDT-TTF)₂I₃ u a smjeru
 - Četiri kontakta od karbon paste debljine ≈ 0.01 cm
 - Naznačene dužine: L = 0.102 cm, w = 0.018 cm, t = 0.002 cm, L₁₂=0.018cm, L₂₃=0.022cm, L₁₄=0.088cm



- Kriostat:
 - 3 posude izolirane dvostrukim stijenkama s vakumom
 - Vanjska posuda uvijek ispunjena LN₂
 - Za hlađenje do temperature LN₂ (77K) središnja posuda ispunjena plinom He
 - Za hlađenja do temperature LHe (77K) središnja posuda ispunjena LHe



- Kriostat:
 - Dijelomična regulacija izmjene topline dodavanjem, odnosno ispompavanjem helija iz stijenke koja okružuje unutarnju posudu
 - Za finu regulaciju koristi se grijač na nosaču uzorka
 - Na nosaču se nalazi i *carbon glass* termometar
 - Mjerenje i regulacija temperature vrši se temperaturnim kontrolorem *LakeShore 34*0



• Kriostat:



- Dielektrična mjerenja:
 - Mjerenje kompleksne admintacije Y=G+iB pomoću analizatora impedancije *HP4248a*
 - Veza admintacije i dielektrične funkcije:

$$\varepsilon'(\omega) = \frac{l}{S} \frac{B(\omega)}{\omega \varepsilon_0} \qquad \varepsilon''(\omega) = \frac{l}{S} \frac{G(\omega) - G_f}{\omega \varepsilon_0}$$

može se izvesti iz 4. Maxwellove jednadžbe; $B=B_{exp}-B_{bg}$; $G=G_{exp}-G_{bg}$; G_f –doprinos slobodnih nosioca naboja

- Frekvencije: 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz i 1MHz
- Od sobne temperature do temperature LHe

- Mjerenja DC otpora:
 - Četverokontaktno (4C) mjerenje pomoću izvora konstantne struje *Keithley 6221* i nanovoltmetara *Keithley 2182a*
 - Od sobne temperature do približno 33K
 - Na 33K otpor ima vrjednost od 5GΩ te mjerenja pomoću ovog postava postaju zahtjevna
 - Dvokontaktno(2C) mjerenje pomoću pikoampermetara i naponskog izvora *Keithley 6487*
 - Približno od 126K do 26K, gdje otpor uzorka (100GΩ) postaje usporediv sa otporom nosača (319GΩ) pa struja "curi" kroz nosač.
- Svi korišteni naponi su unutar područja linearnog odaziva α-(BEDT-TTF)₂I₃ materijal

- Izbačene vrjednosti B koje su barem tri reda veličine manje od G (ograničenje uređaja)
- Izbačene frekvencije od 20Hz i 100Hz



 G₀=0.0128S je vrijednost na sobnoj temperaturi





- Vrh koji se 10000 javlja zbog malog Rast frekvencije relaksacijskog moda 1000 Porastom • 1MHz frekvencije 500kHz ω opada vrh i 200kHz pomjera se 100kHz prema višim 50kHz 100 20kHz temperaturama 10kHz 5kHz 2kHz 1kHz 10 40 60 80 100 20 120 0
 - T (K)

- Ovisnost otpornosti ρ o temperaturi za 4C (crne točke) i 2C (crvene točke) mjerenja DC otpora
- Računanjem otpornosti pomoću vrijednosti dužine L₂₃ za 4C mjernja te L₁₄ za 2C mjernja nismo dobili točno poklapanje, jer je nemoguće točno odrediti te duljine. Stoga su 2C mjerenja pomnožena faktorom 1.54 kako bi se poklopila sa 4C mjernjima.
- 2C mjerenja su također ispravljena zbog paralelnog otpora nosača od 390 GΩ te sistematske pogreške u mjerenju ispod 36.3K s faktorom 1.0737



- Metalno ponašanje iznad T_{MI}
- Poluvodičko ponašanje ispod T_{MI} s prijelomom oko 70K



Zaključak

- Mjerenja otpora pokazuju dobro slaganje s poznatim vrijednostima
- Dielektrična funkcija pokazuje opisane relaksacijske modove oko 70K, ali ne proizvodi očekivani paraelektrično-feroelektrični fazni prijelaz drugog reda na T_{MI}
- Mogući razlozi:
 - Doprinos slobodnih nosioca naboja iznad prijelaza
 - Uređaj nije u mogućnosti točno izmjeriti B zbog velikih vrijednosti G pa prikazuje neku procjenjenu vrijednost koja nije nužno točna.
- Što dalje:
 - Mjerenja pri višim frekvencijama na kojima bi doprinos slobodnih nosioca naboja trebao opasti
 - Dodatni izolacijski sloj između kontakata i površine uzorka kako bi se smanjila vodljivost uzorka

Hvala na pažnji!